

1. Procedeu de obținere a senzorilor care include depunerea chimică a straturilor de oxizi de semiconductor sau de metal pe un substrat în prezența razelor de lumină, caracterizat prin aceea că depunerea chimică se efectuează în prezența razelor ultraviolete, urmată de prelucrarea fototermică rapidă a materialelor obținute, care are loc în vid, în aer sau în camera de gaze, de exemplu, cu oxigen.
2. Procedeu de obținere a senzorilor care include depunerea chimică a straturilor de oxizi de semiconductor sau de metal pe un substrat, în prezența razelor de lumină, caracterizat prin aceea că depunerea chimică se efectuează în prezența razelor ultraviolete, suplimentar are loc doparea materialelor obținute cu cel puțin o impuritate, donor sau acceptor, odată cu depunerea chimică, apoi are loc prelucrarea fototermică rapidă a materialelor obținute, care are loc în vid, în aer sau în camera de gaze, de exemplu, cu oxigen.
3. Procedeu de obținere a senzorilor care include depunerea chimică a straturilor de oxizi de semiconductor sau de metal pe un substrat, în prezența razelor de lumină, caracterizat prin aceea că depunerea chimică se efectuează în prezența razelor ultraviolete, după care, suplimentar are loc doparea materialelor obținute cu cel puțin o impuritate, donor sau acceptor, mai apoi se efectuează prelucrarea fototermică rapidă a materialelor obținute, care are loc în vid, în aer sau în camera de gaze, de exemplu, cu oxigen.
4. Procedeu de obținere a senzorilor care include depunerea chimică a straturilor de oxizi de semiconductor sau de metal pe un substrat, în prezența razelor de lumină, caracterizat prin aceea că depunerea chimică se efectuează în prezența razelor ultraviolete, după care, suplimentar are loc prelucrarea fototermică rapidă a materialelor obținute, care are loc în vid, în aer sau în camera de gaze, de exemplu, cu oxigen, și în același timp se efectuează doparea prin difuzie a lor cu cel puțin o impuritate, donor sau acceptor.
5. Procedeu de obținere a senzorilor care include depunerea straturilor de oxizi de semiconductor sau de metal pe un substrat, în prezența razelor de lumină, caracterizat prin aceea că depunerea chimică are loc în prezența razelor ultraviolete, după care se efectuează suplimentar doparea prin difuzie cu cel puțin o impuritate, donor sau acceptor, concentrația impurităților fiind maxim posibilă pentru materialul obținut, mai apoi se efectuează prelucrarea fototermică rapidă a materialelor obținute, care are loc în vid, în aer sau în camera de gaze, de exemplu, cu oxigen, cu condiția micșorării temperaturii de la temperatura dopării, până la temperatura mediului înconjurător.